

삼성전자, 낸드플래시 세계 1위 굳건

1/4분기 시장점유율 38.5% ... 2014년 4/4분기 10나노급으로 99% 전환

삼성전자(대표 권오현·신종균·윤부근)가 첨단 반도체 미세공정 기술을 앞세워 낸드플래시 메모리 시장점유율을 확대하고 있다.

시장조사기업 iSuppli는 삼성전자가 2013년 1/4분기 낸드플래시 시장점유율 38.5%로 부동의 1위를 지켰다고 7월7일 밝혔다.

1/4분기 삼성전자의 낸드플래시 매출액은 20억3200만달러로 2011년 3/4분기 이후 처음으로 20억달러를 돌파한 것으로 나타났다.

일본 Toshiba가 17억1000만달러로 2위를 차지했으며, 미국 Micron Technology가 9억200만달러, SK하이닉스가 6억3800만달러로 뒤를 이었다.

삼성전자는 2012년 11월 10나노급 64Gb(기가비트) 낸드플래시를 양산한데 이어 2013년 4월 10나노급 128Gb 낸드플래시를 양산하면서 10나노급 공정을 선도하고 있는 것으로 분석되고 있다.

iSuppli는 삼성전자의 10나노급 낸드플래시 생산비중이 1/4분기 9.5%에서 2/4분기 45.3%로 급격하게 확대됐으며 2014년 4/4분기에는 99.0%에 달할 것으로 전망했다.

차세대 주력제품인 10나노급 128Gb 낸드플래시는 현재 주력하고 있는 20나노급 64Gb에 비해 생산성이 2배 이상 높은 것으로 알려졌다.

반면, Toshiba는 1/4분기 10나노급 공정 전환율이 0%로 아직 10나노급을 양산하지 못하고 있는 것으로 파악되고 있다.

iSuppli는 Toshiba의 10나노급 생산비율이 3/4분기 3.5%로 소폭 상승한 후 2014년 4/4분기 74.5%에 이를 것으로 예상했다. SK하이닉스는 1.3%에서 67.0%로 높아질 것으로 내다봤다.

10나노급 공정은 20나노급에 비해 반도체 칩 크기가 1/2 줄어들어 실리콘 웨이퍼 1장으로 생산할 수 있는 칩수가 2배 증가하기 때문에 코스트 경쟁력을 향상시킬 수 있는 것으로 알려졌다.

시장 관계자는 “삼성전자가 낸드플래시 분야에서 경쟁기업들과 1년 가까이 차이를 벌리면서 미세공정 기술을 선도하고 있어 지위가 더욱 강화될 것으로 예상된다”고 말했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2013/07/08>